学位論文

Theoretical Study on Nonlocal Effects in Resonant X-Ray Emission Spectra of Strongly-Correlated Systems

強相関電子系の共鳴X線発光スペクトルに おける非局所効果の理論的研究

西暦 2000 年 1 月 11 日

東京大学大学院理学系研究科

物理学専攻

井手 剛

Contents

1. General Introduction

2. A Model Study on Cluster Size Effects of Resonant X-Ray Emission Spectra

3. Interplay between Raman and Fluorescence-Like Components in Degenerate d⁰ and d¹ systems

4. Local and Nonlocal Excitations in Cu 4p-1s RXES of Nd2CuO4

5. Polarization and Momentum Dependence of Charge-Transfer Exciations in Nd2CuO4

6. Concluding Remarks

Chap.1 General Introduction

何を問題にするのか。

Histrical Survey (§ 1.1)

<u>背景1.</u>新実験技術としての共鳴 X 線散乱



RXES の実験的特色

〇特定元素の特定の殻を選択励起

→ 高エネルギー分光法の一般的特徴

〇表面に鈍感・帯電効果ない

→ 光電子分光法に対する利点

〇共鳴現象の利用:励起状態を「手で」選べる

〇波数選択則と双極子選択則の利用

→ 局所点群の対称性と並進対称性を同時に反映。
 → 波数分解:角度分解光電子分光法と相補的?

× 欠点=信号弱い

→ 高輝度放射光光源が解決

<u>背景2</u>.内殻準位分光法と不純物模型 d 及びf 電子系 ——強相関系の多彩な物理

不純物アンダーソン模型

不純物クラスター模型

 ★ XAS, XPS スペクトルに現れるサテライト機構の解明 (Kotani-Toyozawa, 1973, 1974)

 価電子による内殻正孔の遮蔽

★ Gunnarson-Schönhammer による定式化 (1983)

周期アンダーソン模型 (= 並進群の登場)

★ Cu, Ni 酸化物の 2p-XPS における発見(1993 年)
 非局所遮蔽効果の劇的な寄与(van Veenendaal)
 → 不純物描像の再点検を促す。

<u>背景3</u>.新種の非局所効果の発見

d⁰ 化合物における Ti 3d→2p RXES(手塚ら, 1996)



不純物模型:

XAS, XPS を完璧に再現。 しかし蛍光的成分を説明せず。

→ 新種の非局所効果?



Scope (§ 1.6)

主題: RXES で見た非局所効果

- 1. 新種の非局所効果の解明
 - \rightarrow Chaps. 2 and 3
- 2. XPS で既知の非局所効果の RXES での再発見
 → <u>Chaps. 4</u> and 5
- 3. 新手法としての偏光・運動量依存 RXES の解析
 → Chap. 5

Chap.2 A Model Study on Cluster Size Effects on Resonant X-ray Emission Spectra

それは新種の非局所効果である。

Introduction (§ 2.1)

◇ ラマン成分と蛍光的成分の共存

ラマン成分:入射エネルギー ∝ 射出光エネルギー 蛍光的成分:射出光エネルギーはほぼ一定。

謎: 蛍光成分とNXES スペクトルとの類似

価電子数は一つ減る

原理的に入射光によらない

RXES: 価電子数不変

 $\omega = \Omega - (Ef - Eg)$

入射光の記憶が失われている?

→ 励起サイトからの散逸機構示唆

(cf. d⁰系の分子 TiCl₄)

<u>3d 電子に内在的な遍歴的励起の効果</u>

Formulation (§ 2.2)

並進対称性を持つ最小模型 =非縮退1次元模型。



クラスター模型との対応 : $v = \frac{1}{2} \max\{\langle d^1 \underline{L} | H | d^0 \rangle\}$

◇ RXES の遷移演算子 • Ti 2p→3d→2p 遷移



$$T_{\varepsilon}^{a}(\mathbf{R}) = \sum_{\mu\nu} (d_{\mu} | \varepsilon \cdot \mathbf{p} | p_{\nu}) d_{\mu\mathbf{R}}^{+} p_{\nu\mathbf{R}}$$
$$T_{\varepsilon'}^{e}(\mathbf{R}) = T_{\varepsilon'}^{a}(\mathbf{R})^{+}$$

• 遷移演算子 (q=k_{発光}-k_{入射})

$$T_{\varepsilon',\varepsilon}(\Omega;\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}} T^{e}_{\varepsilon'}(\mathbf{R}) \frac{1}{E_{g} + \Omega - H + i\Gamma} T^{a}_{\varepsilon}(\mathbf{R})$$

主に Auger 項による寄与 ―」

Calculated Resluts (§ 2.3)

◇ RXES における顕著な非局所効果



<u>RXES</u>

不純物クラスター:ラマン成分のみ

大きなクラスター: 蛍光的成分が出現

(XPS, XAS, f⁰系の RXES →不純物近似妥当)

Discussion ($\S 2.4$)

NXES

RXES

-30

-20

-10

Emitted Photon Energy [eV]

0

◇ 相互作用のない系との比較

coherent

core-fixed

相互作用なし

(&内殻固定)

→ スペクトルが

Ωによらない



10

 $2\overline{0}$

30

20

-10

XAS

 $\Delta = 4.0$ v=3.5

 $U_{dd}=0.$

 d_6p_6

d⁰ 系

中間状態に1 電子的 な遍歴的励起



Conclusions (§ 2.5)

◇ RXESとNXESの関係

ー励起電子の散逸機構



(b) fluorescence-like resonant emission



Chap.3 Interplay between Raman and Fluorescence-Like Components in Degenerate d⁰ and d¹ systems

局所対称性と並進対称性の競演。

Introduction (§ 3.1)

◇ 非縮退模型の限界

局所対称性の役割が不明

→ 非結合軌道存在せず

ラマン成分の強度が弱い

d¹系(MH系)の計算

(実験:明瞭な蛍光的成分とラマン成分)

→占有・非占有軌道の役割

※d¹系との中間状態の違い

◇ フォノン機構との関係

疑問: Ti から Ni 酸化物まで例外なく蛍光的成分が出現

電子機構だけで、ラマン成分・蛍光的成分

の共存は言えるのでは?

Formulation (§ 3.2)

◇ 2 重縮退模型

局所的に2つの点群的対称性をもつ周期アンダーソン模型。



- 1. 不純物クラスターとの比較
- 2. 非縮退模型との比較
- 3. filling による比較(d⁰か d¹か)

Calculated Results I:

Band Insulators (§ 3.3)

◇ 2 重縮退•d⁰配置

XAS の2つの主ピーク → TiO2 の L3 吸収の t2g, egピーク

ラマン成分に2種類

•非結合性

·反結合性





Calculated Results II: MH Insulators (§ 3.4)

◇ 非縮退・d¹配置(t2gバンドを模擬)

<u>不純物クラスター</u> ・XAS は <u>c</u>d²のみ ・ラマン成分のみ (局所的 CT 励起)

20 nondeg. (a) NXES d^1 Relative Photon Energy [eV] 8 x 420 7 x 320 8 6 x 240 7. 6 5 5 4 x 160 4 x 100 3 2 3 x 60 2 x 30 single 1 x 1 -10 -20 -10 10 0 Emitted Photon Energy [eV] 20 nondeg. (b) NXES d^1 Relative Photon Energy [eV] x 50 8 10 x 100 7 8 x 200 6 7 6 x 50 5 5 4 4 x 2 3 2 x 8 3 2 x 8 d_4p_4 x 1 1 -10 -20 -10 0 10

Emitted Photon Energy [eV]

<u>大きなクラスター</u>

・XAS に副ピーク

・2 系統のラマン成分

─ CT 励起 └ ─ サイト間 dd 励起

◇ 2 重縮退•d¹ 配置

「ラマンシフト」 ω(出)ーΩ(入)

= Eg-Ef(電荷励起)

- ___ サイト内 dd 励起 └__ 局所的 CT 励起 ___ サイト間 dd 励起
 - 非局所的 CT 励起

蛍光的成分が現れている。



Conlusions (§ 3.6)

d⁰ 系

- 非結合性 → 非摂動基底状態と対称性異なる

1. 局所点群

2. 縮退軌道同士の置換対称性

反結合性 → 非摂動基底状態と対称性同じ

・ 蛍光的成分 → 並進対称性の現れ

- 非結合性

┼ 反結合性

└ サイト内 dd 励起

蛍光的成分 →並進対称性の現れ

中間状態の遍歴的励起 = d⁰と異なる

Chap.4 Local and Nonlocal Excitations in Cu 4p-1s Resonant X-Ray Emission Spectra of Nd₂CuO₄

「ポテンシャル・ドーピング」による

Zhang-Rice1重項形成。

その本質的寄与を RXES において確認した。

Introduction (§ 4.1)

◇ Cu 2p-XPS と「ポテンシャル・ドーピング」

非ドープ系の母物質/価電子(Cu 3dとO 2p)数は不変



内殻正孔ポテンシャルによる ZR 1 重項状態 → Cu 2p-XPS の主ピークを与える 「<mark>非局所遮蔽効果</mark>」

◇ Cu 4p-1s RXES の遷移過程

Nd2CuO4:電子ドープで高温超伝導

形式価数:3d⁹ → <u>強相関</u>絶縁体



中間状態=2p-XPSの終状態に似る

→ Zhang-Rice 1 重項関与?

非局所遮蔽効果は RXES にどう効いているのか

◇ 問題の所在

吸収の主ピーク励起

→ 6eVピークが殆ど見えない

発光強度の抑制機構の由来は?



Energy Loss =(入射)—(射出) = Ef - Eg

■ Formulation(§4.2) ◇ Nd2CuO4のモデル





(a) Cu₅O₁₆ cluster

<u>結果の比較</u>

不純物アンダーソン模型

Cu5O16 クラスター模型



Analysis with Impurity Anderson Model (§ 4.3)

◇ 不純物模型で見た電子状態(部分状態密度)

励起状態の分類: 3d 軌道と分子軌道 A, B, C の重み





- 基底状態∶*結合状態 (中心 3d 軌道と最近接 2p 軌道から成る)*
 - 2eV 励起: 非結合状態
 (酸素 2p バンドの下端)

O 6eV 励起: 反結合状態

◇ 不純物模型による RXES の解析
 XAS, RXES とも、比較的よく実験を再現
 6eVピークの入射光依存性(右)=実験と異なる
 → 不純物模型での記述の限界示唆



(単一区画の CuO4 模型なら完全な U 字型)

Analysis with Multi-Cu Model (§ 4.4)

◇CuO₂ 平面の電子状態 (部分状態密度)







※ 中間状態(吸収の終状態)
 主吸収ピーク:inter-plaquette CT

 → 周辺区画で局所1重項

 主ピーク肩:intra-plaquette CT

 → 最近接酸素軌道との反結合性軌道

 副ピーク:Cu 3d 軌道に正孔局在

※ 終状態

2eV 励起:inter-plaquette CT → 局所1重項形成 6eV 励起:intra-plaquette CT → いずれかの区画で反結合性軌道

◇実験結果との一致



- 吸収の主ピークに共鳴した時
- •6eV ピーク抑制
- •2eVピーク増大

→ 励起の空間的広がりの違いを反映

◇ RXES で動的に捉えたギャップ構造 (6eV 励起の抑制機構)



電荷移動ギャップ

→ Zhang-Rice singlet band への正孔の励起

◇ 移行運動量(q)依存性(Chap. 5)



Conclusions (§ 4.5)

不純物模型

•おおむね実験を再現。

•6 eV ピークの入射光依存性における不一致

大きなクラスター模型

・実験との満足しうる一致

RXES の入射光依存性

→ 電荷励起の空間的広がりの大小の直接の反映 (*inter- or intra-plaquette*)

ZRT XAS の主ピークsinglet電荷ギャップを担う2 eV 励起

Chap.6 Concluding Remarks

新種の非局所効果の解明

Chap.2: 非縮退模型により、 蛍光成分の由来を

電子機構で説明

<u>Chap.3</u>:軌道縮退のある模型で, 蛍光成分と ラマン成分の共存を電子機構により説明

非局所遮蔽効果の RXES における役割の解明 Chap.4: Nd2CuO4のCu 4pπ-1s RXES において 非局所遮蔽効果の本質的寄与を実証

新技術としての RXES の適用例の説明

<u>Chap.5</u>:Nd2CuO4 Cu 4p−1s RXESの偏光•移行運動量依 存性を検討